



NEW DIAMOND TECHNOLOGY

[トップ](#)[テクノロジー](#)[特性](#)[生産](#)[仕様](#)[生産能力](#)[レンズ](#)[品質](#)[会社概要](#)

	Si	4H-SiC	GaN (epi)	Grown Diamond
バンドギャップ E_g , (eV)	1,12	3,23	3,44	5,5
電子濃度 n_i , (cm ⁻³)	$1,5 \times 10^{-10}$	$8,2 \times 10^{-9}$	$1,9 \times 10^{-10}$	$1,6 \times 10^{-27}$
誘電率 ϵ_r	11,9	9,8	9	5,0
臨界電界 E_c , MV/cm	0,3	2,2	2,0	5,0
電子移動度 μ_n , cm ² /Vs	1350	900	1150	4500
電子移動度 μ_p , cm ² /Vs	480	120	200	3800
飽和速度 v_s , 10 ⁷ cm/s	1,0	2,0	3,0	2,7
熱伝導率 λ , W/cmK	1,5	5	2	22
最大動作温度 T_{max} (C)	175	500	650	900
絶縁破壊電界 (E_{br} , MV/cm)	0,3	3	3,3	10

VISION DEVELOPMENT CO.,LTD



NEW DIAMOND
TECHNOLOGY

グローン ダイヤモンド(製品、製造装置等)についてのご相談やご質問等がありましたら問い合わせフォームに記載の上、ビジョン開発(株)までにFAXもしくはメールにてお問い合わせください。

輸入販売

ビジョン開発株式会社

営業事務所

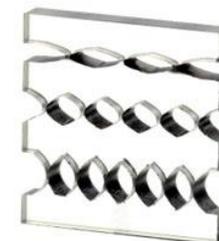
〒222-0033

横浜市港北区新横浜3-6-12 日総第12ビル2階

TEL:045-624-9933

FAX:045-624-9934

E-mail:k-vision@rapid.ocn.ne.jp



VISION DEVELOPMENT CO.,LTD